Shantou Huashan Electronic Devices Co.,Ltd.

NPN SILICON TRANSISTOR

H3619

APPLICATIONS

High Voltage switching And amplifier.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS（T_a=25℃）

T_{stg}——Storage Temperature…… −55~150℃

T_j——Junction Temperature…… 150℃

P_C——Collector Dissipation（T_c=25℃）…… 1.5W

V_{CBO}——Collector-Base Voltage…… 300V

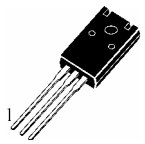
V_{CEO}——Collector-Emitter Voltage…… 300V

V_{EBO}——Emitter-Base Voltage…… 7V

I_C——Collector Current……100mA

Ib——Base Current……50mA

TO-126ML



1－Emitter，E
2－Collector，C
3－Base，B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS（T_a=25℃）

Symbol	Characteristics	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
I_{CBO}	Collector Cut-off Current			1.0	μA	V_{CB}=240V, I_E=0
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current			1.0	μA	V_{EB}=7V, I_C=0
H_{FE}（1）	DC Current Gain	20				V_{CE}=10V, I_C=4mA
H_{FE}（2）	DC Current Gain	30		200		V_{CE}=10V, I_C=20mA
$V_{CE(sat)}$	Collector- Emitter Saturation Voltage			1.0	V	I_C=10mA, I_B=1mA
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage			1.0	V	I_C=10mA, I_B=1mA
ft	Current Gain-Bandwidth Product	50			MHz	V_{CE}=10V, I_C=20mA,
Cob	Output Capacitance		30		pF	V_{CB}=20V, I_E=0,f=1MHz